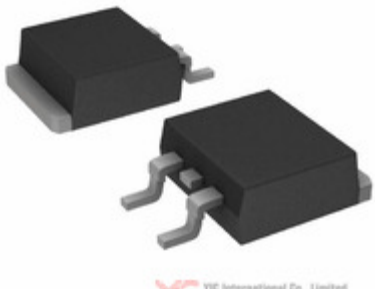




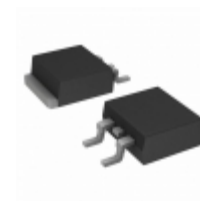



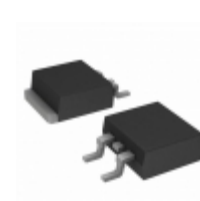
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R190P6ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R190P6ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R190P6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 630µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	CoolMOS™ P6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	151W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1750pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

IPB60R190P6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB60R190P6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB60R190P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB60R190P6ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB60R199CP Infineon Technologies IPB60R199CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R190C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 20.2A TO263</p>	 <p>IPB60R199CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 16A TO-263</p>	 <p>IPB60R199CPAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB60R199CP/6R199P INF IPB60R199CP/6R199P INF</p>	 <p>IPB60R180P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>	 <p>IPB60R190C6 Infineon Technologies IPB60R190C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R230P6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 16.8A 3TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB60R190P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB60R190P6ATMA1 Datenblatt	IPB60R190P6ATMA1-Datenblätter	IPB60R190P6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R190P6ATMA1
IPB60R190P6ATMA1 Electronic	IPB60R190P6ATMA1-Komponenten	IPB60R190P6ATMA1-Verteiler	IPB60R190P6ATMA1-Bild	IPB60R190P6ATMA1-Teil
IPB60R190P6ATMA1 Preis	IPB60R190P6ATMA1 Hersteller	IPB60R190P6ATMA1 Bild	IPB60R190P6ATMA1 Aktie	IPB60R190P6ATMA1 Inventar
IPB60R190P6ATMA1 Neu	IPB60R190P6ATMA1 Original	IPB60R190P6ATMA1 garantiert	IPB60R190P6ATMA1 RFQ	IPB60R190P6ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited